

# 2SC2832, 2SC2832A

シリコン NPN 三重拡散メサ形 / Si NPN Triple Diffused Junction Mesa

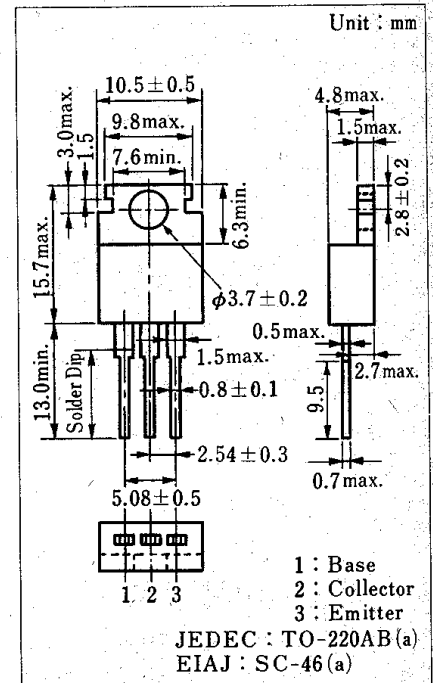
高速スイッチング用 / High Speed Switching

### ■ 特徴 / Features

- スイッチング速度が速い。 / High speed switching
- コレクタ・ベース電圧  $V_{CB0}$  が高い。 / High  $V_{CB0}$
- コレクタ・エミッタ飽和電圧  $V_{CE(sat)}$  が低い。 / Low  $V_{CE(sat)}$

### ■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit	
コレクタ・ベース電圧	$V_{CB0}$	2SC2832	800	V
		2SC2832A	900	
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	500	V	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	8	V	
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	10	A	
コレクタ電流	$I_C$	5	A	
ベース電流	$I_B$	3	A	
コレクタ損失 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	40	W	
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$	
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$	



### ■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_c=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=800\text{ V}, I_E=0$			100	$\mu\text{A}$
		$V_{CB}=900\text{ V}, I_E=0$			100	
エミッタしゃ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5\text{ V}, I_C=0$			100	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO(sus)}$	$I_C=0.2\text{ A}, L=25\text{ mH}$	500			V
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE}=5\text{ V}, I_C=0.1\text{ A}$	15			
	$h_{FE2}$	$V_{CE}=5\text{ V}, I_C=3\text{ A}$	8			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3\text{ A}, I_B=0.6\text{ A}$			1	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=3\text{ A}, I_B=0.6\text{ A}$			1.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=0.5\text{ A}$		3		MHz
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C=3\text{ A}$			1	$\mu\text{s}$
					1.2	
蓄積時間	$t_{stg}$	$I_{B1}=0.6\text{ A}, I_{B2}=-0.6\text{ A}$			3	$\mu\text{s}$
下降時間	$t_f$	$V_{CC}=200\text{ V}$			1	$\mu\text{s}$
					1.2	